PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-053258

(43) Date of publication of application: 20.02.1992

(51)Int.CI.

H01L 27/04

(21)Application number : 02-161728

61728 (71)Applicant:

(22)Date of filing:

20.06.1990

(72)Inventor:

SEIKO EPSON CORP

: KUB

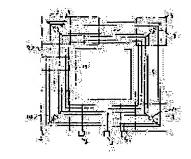
KUBOKAWA MICHIYA

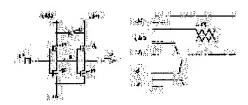
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable a semiconductor device to operate even if the power supply of a second power supply terminal is shut off on standby or in sleep by a method wherein a diode is connected between a first and a second power supply terminal at the corner of a chip so that the biasing in the direction of the first to the second terminal may be the forward biasing.

CONSTITUTION: A first power supply terminal vdd1 is supplied from a PAD2 and connected to a logic inside a chip, and a second power supply terminal vdd2 is also supplied from the PAD1. A ground terminal vss is connected to a PAD3 and connected to the logic 12 inside the chip. At this point, diode means 8, 9, 10, and 11 are connected to the corner of the chip so that the biasing in the direction of the first power supply terminal vdd1 to the second power supply terminal vdd2 may be the forward biasing. In result, even if the second power supply terminal vdd2 is cut off, as the second power supply terminal vdd2 is supplied from the first power supply terminal vdd1 through the intermediary of the diode means 8, 9, 10, and 11, a logic can be kept stable.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-53258

®Int. Cl. 5

庁内整理番号 識別記号

❸公開 平成 4年(1992) 2月20日

H 01 L 27/04

D 7514-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

69発明の名称 半導体装置

> ②特 頭 平2-161728

願 平2(1990)6月20日 22出

道矢 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式 @発 明者 久保川

会社内

セイコーエプソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 勿出 題 人

会社

弁理士 鈴木 喜三郎 外1名. 個代 理 人

詽

1. 発明の名称

半導体裝置

2. 特許請求の範囲

2つの電源系を内蔵している半導体装置に於

- (a) 第一の電源端子手段、
- (b) 第一の電源端子手段よりも高い電圧が印加 されている第二の電源端子手段、
- (c) 第一の電源端子手段から第二の電源端子手 段の方向が順方向バイアスであり、第二の電源端 子手段から第一の電源端子手段の方向が逆バイア スに接続された第一のダイオード手段、
- (d) 第一のダイオード手段が前記半導体装置に 於てコーナー部に少なくとも一つあることを特徴 とする半導体装置。

1

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は2つの電源系を内蔵している半導体装 置に関する。

「従来の技術」

従来の2つの電源系を内蔵している半導体装置 の入出力(I/0)セルにおいては、第3図のよ うに第二の電源端子 (vdd2) が第一段目の入 カ回路に接続され、第一の電源端子 (vdd1) が第二段目の入力回路に接続されている。このと き第二の電源端子(vdd2)の電圧は第一の電 源端子(vddl)の電圧より高いものとする。 通常の動作では二つの電源端子とも電源が供給さ れており、スタンバイ状態やスリーブ状態でも二 つの端子に電源を供給していた。

[発明が解決しようとする課題]

しかし従来の回路構成の問題点としては、パワ ーを節約するために第二の電源端子 (vdd2) の電源を切った場合に、第3図において第一段目 の入力回路の電源が供給されなくなるのでBの信 号が不定となって第二段目の入力回路も不定とな

والمحمدين

り、かつこの回路にはショート電流が流れるた め、この半導体装置は動作しなくなる。

これを避けるために別のバックアップ電源から 新たに電源を供給しなければならず、性能、価格 の面での問題が大であった。

そこで本発明はこのような問題点を解決するもので、その目的とするところは、バックアップ時あるいはスリープ時などパワーを下げたいときに第二の電源端子(vdd2)の電源を切っても動作が出来、かつパワーの低い半導体演算装置を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

2 つの電源系を内蔵している半導体装置に於 て、

- (a) 第一の電源端子手段、
- (b) 第一の電源端子手段よりも高い電圧が印加されている第二の電源端子手段、
- (c)第一の電源端子手段から第二の電源端子手段の方向が順方向バイアスであり、第二の電源端子手段から第一の電源端子手段の方向が逆バイア

3

きに従来は I / O セルがおけなくて無駄なスペースとなっている、半導体装置のコーナー部を使うことで比較的大きなダイオードを簡単に作ることが出来る特徴を有する。

〔寒 施 例〕

第1図は本発明の実施例の半導体装置のレイアウト図である。また第2図は第1図のダイオード部を回路と組み合わせたものである。また第4図は第二の電源端子(vdd2)が途中で切られて不定状態になったときの本発明による動作を分かりやすく説明するためのタイミングチャート図である。第1図、第2図および第4図に従って説明を進めることにする。

第1図において、第二の電源端子(vdd2)はチップの最外周を回っており、第一の電源端子(vdd1)はその内側を回っている。そして接地端子(vss)は更にその内側を回っている。第一の電源端子(vdd1)はPAD(2)より供給され、チップ内部のロジックに接続されており、第二の電源端子(vdd2)もPAD(1)

5

スに接続された第一のダイオード手段、

(d) 第一のダイオード手段が前記半導体装置に 於てコーナー部に少なくとも一つあることを特徴 とする。

〔作 用〕

本発明の上記の構成による特徴を以下に第1図 と第2図及び第4図に従って説明する。

第1図において、第一の電源端子(vdd1)と第二の電源端子(vdd2)の間に第一の電源端子(vdd1)から第二の電源端子(vdd2)の方向が順バイアスである第一のダイオードを接続する。これにより第4図において第二の電源端子(vdd2)が切られてしまっても第一の電源端子(vdd2)に供給されBの倡号が不定になることはなくなる。

このことにより、スタンバイ時、スリーブ時において第二の電源端子(vdd2)の電源を切ったとしてもこの半導体装置は動作可能である。また実際にこの回路を半導体装置として構成すると

4

より供給されている。接地端子(vss)はPA D (3) につながり、チップの内部のロジック (12)に接続されている。チップの周辺部には 1/0セル(22)が並んでいる。このときチッ プのコーナー部(4、5、6、7)はI/0セル (22) はおくことが出来ないので、ほとんどの 場合無駄なスペースとなってしまうので通常は電 源線である第一の電源端子 (vdd1)、第二の 電源端子(vdd2)と接地端子(vss)を回 しているだけである。本発明ではこのコーナー部 にダイオード手段を配置することで無駄なスペー スを有効に使うことが可能になる。また第1図の 中に示されているようにダイオード手段(8、 9、10、11) を第一の電源端子(vdd1) から第二の電源端子(vdd2)の方向が順方向 になるように接続することで、もしも第二の電源 端子(vdd2)が切られて不定状態になったと しても、第一の電源端子(vddl)からダイオ ード手段の8、9、10、11を通して第一の電 源端子(Vddl)からVddlの電圧が第二の

電源端子(vdd2)に供給されるために第二の電源端子(vdd2)に接続されているロジック部が浮いてしまうことによるロジック部の不定やショート電流が次段のロジックに流されることはなくなる。

第4図はその状態をタイミング図で示は子でのである。図中のXのところで第二の電源端子ののところで第二の電源端子ののところで第二の電源に、第一ののは、第一ののである。図中のXのところで第二ののでは、第一のでは、第二のでは、からないないが、第二のでは、ないで、第二のでは、ないで、第二のでは、ないで、第二のには、ないで、第二のに、第一の電源端子(vdd1)

7

[発明の効果]

以上述べたように、本発明の上記の構成によれ ば第一の電源端子 (Vddl) と第二の電源端子 (Vdd2)の間に第一の電源端子(Vdd1) から第二の電源端子(Vdd2)の方向が順バイ アスである第一のダイオードを接続し、これによ り第二の電源端子(Vdd2)が切られてしまっ ても第一の電源端子(Vddl)から第一のダイ オードを通して電源が第二の電源端子(Vdd 2) に供給され、スタンバイ時、スリープ時にお いて第二の電源端子(Vdd2)の電源を切った としてもこの半導体装置は動作可能であり、また 実際にこの回路を半導体装置として構成するとき に従来は I / O セルがおけなくて無駄なスペース となっている半導体装置のコーナー部を使うこと でチップの面積の節約も可能であるという特徴を もちその効果は絶大なものがある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す半導体装置の

9

からダイオード手段(13)を通して第一の電話 端子(vdd1)からvddlの電圧が第二のの電 源端子(vdd2)に供給されているロジックの であるインバータのPCH MOSトランジシかか vddlの電圧が印加されているのでPCH M OSトランジスタが浮くことはなくドレインの のカカであるインバータの入力も確定するために っの部分でのショート電流が流れることはない。

本実施例ではダイオード手段をチップの各コーナー部分に入れているが、これは少なくとも一箇所入っていれば動作は可能である。また電源線のvddl、vddl、vssの順番も任意で構わない。また、ダイオード手段としては、たんにダイオードだけに制限されず、トランジスタを使ったとしても電流はvddlからvdd2へ流すことは可能であり同等の効果を有することは明かである。

8

レイアウト図。

第2図は本発明の一実施例の回路図。

第3図は従来の回路図の一例を示す図。

第4図は第1図の動作を示したタイミングチャート図。

第5図は第3図の動作を示したタイミングチャート図。

1・・第二の電源端子(Vdd2)のPAD

2 · · 第一の電源端子 (V d d l) の P A D

3··接地端子 (vss) のPAD

4・・半導体装置のコーナー部

5・・半導体装置のコーナー部

6・・半導体装置のコーナー部

7・・半導体装置のコーナー部

8 · ・ダイオード手段

9 ・・ダイオード手段

10・・ダイオード手段

11・・ダイオード手段

12・・ロジック部

13・・ダイオード手段

14・・P型MOS トランジスタ

15・・N型MOS トランジスタ

16・・P型MOS トランジスタ

17・・N型MOS ·トランジスタ

18・・P型MOS トランジスタ

19・・N型MOS トランジス:

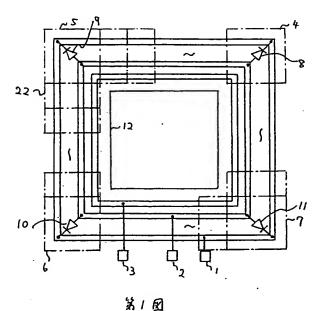
20・・P型MOS トランジスタ

21・・N型MOS トランジスタ

22・・半導体装置のI/0セル

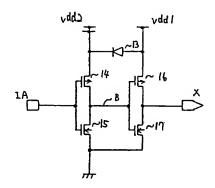
以上

出願人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 鈴 木 喜三郎 (他1名)

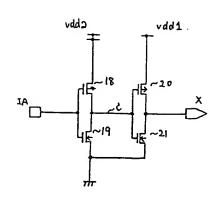


...

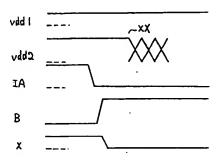
1 1



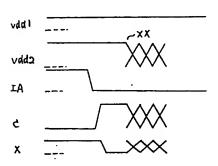
第2 图



第3 図



第4國



第5图